	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XP005E	文件编号	临时
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	18-B1-06
		页码	1/2

1 主要用途及主要特点

1.1 主要用途

用 W2XP005E 封装的成品管主要用于 MP3 的功放电路中。

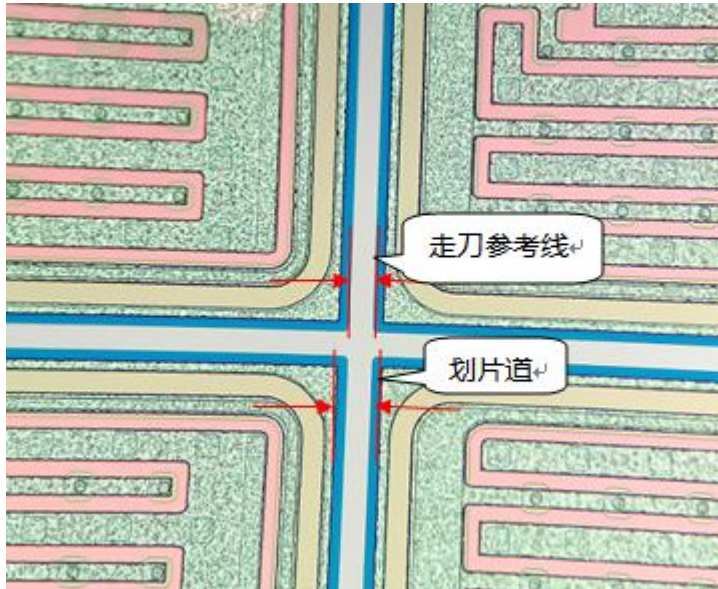
1.2 主要特点

- 饱和压降低
- 电流特性好

2 芯片数据

芯片示意图 	芯片尺寸 (mm×mm)		0.90×0.90
	芯片厚度 (μm) (推荐)		220±20
	划片道* 尺寸 (μm)		40
	键合区面积 (μm ²)	基区	150×160
		发射区	145×160
	钝化层		Si ₃ N ₄
	正面电极	金属	铝
		厚度 (μm)	4.0±0.6
	背面电极	金属	金
	硅片直径 (mm)		φ125
	装片要求 (推荐)		共晶
	键合要求 (推荐)		铜丝: Φ42μm; E、B 区各一根

* 划片道位置示意图:



备注: 划片道两侧的铝条不断裂即判为合格。

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)


江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: <http://www.xs-elec.com>

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XP005E	文件编号	临时
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	18-B1-06
		页 码	2/2

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
集电极-基极电压	V_{CB0}	-40	V	推荐封装形式: T0-92 推荐成品型号: 2SB1182
集电极-发射极电压	V_{CE0}	-40	V	
发射极-基极电压	V_{EB0}	-5	V	
集电极电流	I_C	-2	A	
耗散功率($T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$)	P_{tot}	0.8	W	
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I_{CB0}	$V_{CB} = -40\text{V}, I_E = -0$			-0.1	μA
发射极-基极截止电流	I_{EB0}	$V_{EB} = -5\text{V}, I_C = -0$			-0.1	μA
共发射极正向电流传输比的静态值	h_{FE}	$V_E = -2\text{V}, I_C = -500\text{mA}$	40		250	
集电极-发射极饱和电压	V_{CEsat}	$I_C = -1.0\text{A}, I_E = -100\text{mA}$			-0.5	V
特征频率	f_T	$V_E = -5\text{V}, I_C = -50\text{mA}$ $f = 30\text{MHz}$	50			MHz

注意事项:

- 芯片存储条件(推荐): 氮气保护, 温度 $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$, 湿度 $\leq 45\%$;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地 址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: <http://www.xs-elec.com>

电 话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532